GaAs 限幅器芯片 6-13GHz

主要性能

◎ 工作频段: 6~13GHz

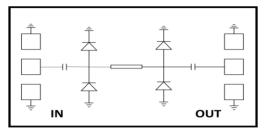
插入损耗: 0.38 dB@8GHz (typ.) 最大输入功率: 20W (CW)@9GHz

20W (CW)@6GHz 20W (CW)@13GHz

◎ 芯片尺寸: 1.468 x 0.927 x 0.1mm

◎ 输入、输出端皆有隔直电容

功能框图



产品简介

该限幅器芯片具有较低的插损和优良的限幅特性,非常适用于微波混合集成电路及TR组件模块等领域。 该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接 工艺。可应用于以下范围:

◎ 无线通信设备 ◎ 军事和航天

◎ 测试仪器 ◎ 雷达和电子对抗

极限参数

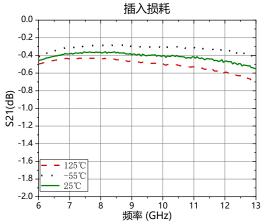
指标	数值	备注
最大输入功率	20W@9GHz	CW, +25°C
	20W@6GHz	CW, +25°C
	20W@13GHz	CW, +25°C
烧结温度	290°C	1
存储温度	-55~150°C	-
工作温度	-55~125°C	-

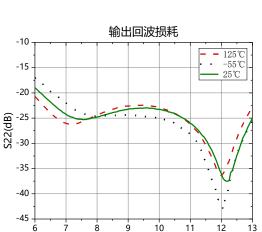
注: 超过最大值都有可能造成永久性损坏

电性能表 (TA=+25℃)

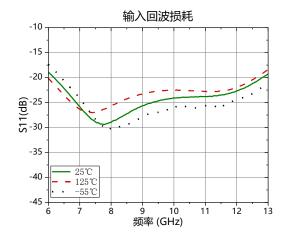
指标	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	-	0.38	-	dB
回波损耗	18	24	27	dB
限幅电平	-	14(6GHz)	-	dBm
	-	14(7GHz)	-	dBm
	-	13(8GHz)	-	dBm
	-	13.7(9GHz)	-	dBm
	-	14(10GHz)	-	dBm
	-	13(11GHz)	-	dBm
	-	13(12GHz)	-	dBm
	-	12(13GHz)	-	dBm
	-	13.8(14GHz)	-	dBm

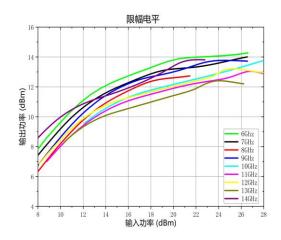
典型测试曲线



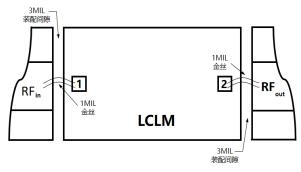


频率 (GHz)





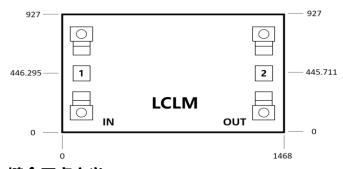
装配示意图



说明:

- 1. 单位: 微米 (um), 尺寸公差: ±50um
- 2. 键合压点镀金, 压点尺寸: 100um x 100um
- 3. 芯片背面镀金
- 4. 芯片背面接地
- 5. 不可在通孔上进行键合
- 6. 压点间隙: 150um (GSG)

芯片尺寸图



键合压点定义

压点	功能	功能描述	
编号	符号	り 能抽 处	
1	RFin	RF 输入端,阻抗 50 Ω	
2	RFout	RF 输出端,阻抗 50 Ω	
-	GND	芯片背面必须接地	

耐受功率Demo测试结果

耐受功率	测试时长
20W (CW)@6GHz	5min
20W (CW)@9GHz	1min
20W (CW)@13GHz	5min
50W (PW 3ms 10%)@9GHz	1min
20W (CW)@7、8、10、11、12GHz	1min

版本修订

修改内容	修订时间
新增补测频点耐受功率	2024.07.10
新增耐受功率测试频点	2024.11.28